

Установка ВУП-11М

1. Технологические источники:

1) Магнетрон 4" (100 мм), расположен слева от дверцы.

Материалы: Si, Sn, Cr, W, Mo, Ta, Ni, Al, Ti, Cu, V, X20H80, Кермет К-20С (Cr 37,0 - 39,3 %. Сплав РС-4800 со стеклом С44-1), РС-3710 (Cr - 37%, Ni - 10%, Si - 53%).

Источники питания:

RF (Cesar 1310);

DC и Pulsed DC (APEL-M-1.5PDC-800-2).

2) Магнетрон 2" (50 мм),

Может располагаться сверху установки, нанесение двухкомпонентных покрытий совместно с магнетроном 4" на подложку под углом (рис. 1).

Материалы: SnO, Cu, Cr, W, Si.

Источники питания:

RF (Cesar 1310);

DC и Pulsed DC (APEL-M-1.5PDC-800-2).

3) Магнетроны 2" (50 мм) (Co sputtering),

Располагаются на нижнем фланце под углом, для повышения неравномерности при нанесении на вращающуюся подложку (рис. 2).

Материалы: Nb, Ge, Ag, SiO₂, TiO₂, SnO, Cu, Cr, W, Si.

Источники питания:

RF (Cesar 1310);

DC и Pulsed DC (APEL-M-1.5PDC-800-2).

2. Технологические газы: Ar, O₂, N₂.

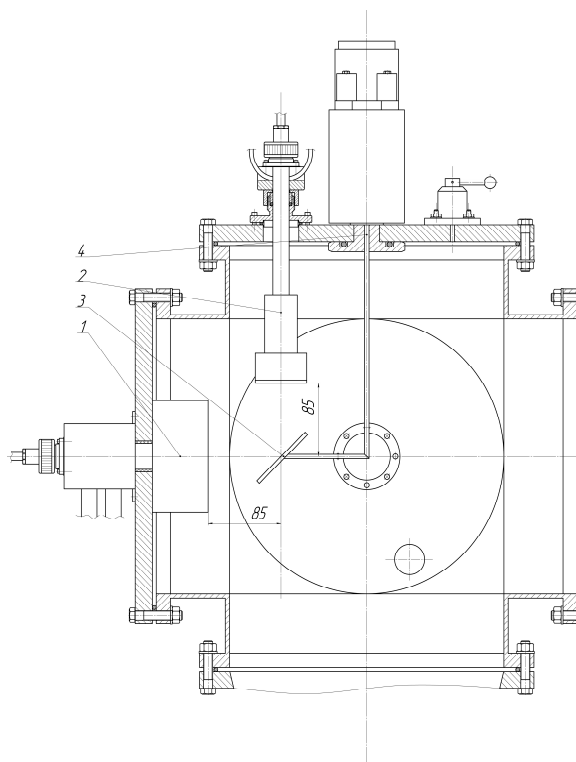


Рисунок 1 – Чертеж установки ВУП-11М с установленным сверху вторым магнетроном

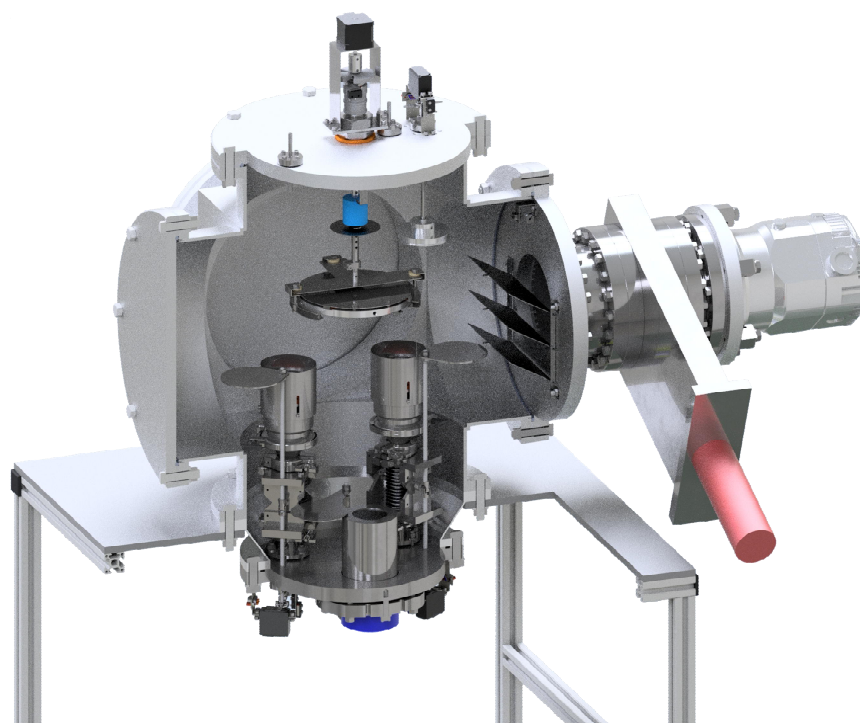


Рисунок 2 – Чертеж установки ВУП-11М в конфигурации «Co sputtering»
(2 магнетрона 2” на нижнем фланце под углом к подложке)